

**祁菁**

副教授

性别：女

大学物理实验教学中心

地址：兰州市天水南路222号，兰州大学物理科学与技术学院

电话：

传真：0931-8913554

电子邮件：qijing@lzu.edu.cn

个人简介：

- 1、2009年8月- 加州大学河滨分校（博士后）
- 2、2002年8月-2006年12月 兰州大学（理学博士）
- 3、1997年8月-2000年7月 兰州大学（工学硕士）
- 4、1993年8月-1997年7月 兰州大学（工学学士）

研究方向：

- 1、自旋电子学材料及器件
- 2、半导体材料及器件

实验室就像一个游乐场，其美妙之处在于游客不仅可以看到各种奇景妙观，而且可以利用游乐场中的设施实现自己的奇思妙想！

科研项目

5. 项目名称：透明室温铁磁半导体 $Zn_{1-x}Er_xO$ 的制备及磁性机理研究

经费来源：国家自然科学基金（项目编号：50902065；20万）

执行年限：2010年1月1日-2012年12月31日

参与情况：主持

4. 项目名称：过渡金属掺杂硅基稀磁半导体薄膜材料的制备及特性研究

经费来源：省自然科学基金计划（项目编号：0710RJZA023；2.0万元）

执行年限：2008年1月至2010年12月

参与情况：主持

3. 项目名称：稀磁半导体材料 $Zn_{1-x}Er_xO$ 薄膜的制备及特性研究

研究工作：

经费来源：2008年磁学与磁性材料教育部重点实验室开放课题项目

（项目编号：MMM200812；1.0万）

执行年限：2008年10月至2009年10月

参与情况：主持

2. 项目名称：过渡金属掺杂ZnO基稀磁半导体薄膜材料的制备及特性研究

经费来源：兰州大学物理科学与技术学院青年教师资助计划

(项目编号：WL200701；1.0万)

执行年限：2007年10月至2009年10月

参与情况：主持

1. 项目名称：镁离子二次电池氧化物正极材料的制备和特性研究

经费来源：国家自然科学基金项目（项目编号：50402024；25万元）

执行年限：2005年1月至2007年12月

参与情况：主要成员

- 14、Li Zhang, Shihui Ge, Yalu Zuo, Juan Wang and Jing Qi, *Scripta Materialia*, 63 (2010) 953– 956
- 13、Jing Qi, Daqiang Gao, Jinhong Liu, Wenge Yang, Qi Wang, Jinyuan Zhou, Yinghu Yang, Jianlin Liu, Magnetic properties of Er-doped ZnO films prepared by reactive magnetron sputtering, *Appl Phys A* 100 (2010) 79– 82
- 12、Daqiang Gao, Jing Zhang, Jingyi Zhu, Jing Qi, Zhaohui Zhang, Wenbo Sui, Hui gang Shi and Desheng Xue, Vacancy-Mediated Magnetism in Pure Copper Oxide Nanoparticles, *Nanoscale Research Letters*, DOI 10.1007/s11671-010-9555-8
- 11、Jing Qi, Daqiang Gao, Li Zhang and Yinghu Yang, Room-temperature Ferromagnetism of the Amorphous Cu-doped ZnO thin films, *Applied Surface Science*, 256, 2507-2508 (2010)
- 10、Daqiang Gao, Zhaohui Zhang, Junli Fu, Yan Xu, Jing Qi, and Desheng Xue, Room temperature ferromagnetism of pure ZnO nanoparticles, *J. Appl. Phys.* 105, 113928 (2009)
- 9、Jing Qi, Yinghu Yang, Li Zhang, Junhong Chi, Daqiang Gao, Desheng Xue, Room-temperature ferromagnetism in Er-doped ZnO thin films. *Scripta Materialia* 60, 289– 292(2009)
- 8、Jing Qi, Yang Yang, Deyan He, Polycrystalline silicon-germanium Films Prepared by Aluminum-induced crystallization, *J. Electrochem. Soc.*, 155, H903-H908 (2008)
- 7、Jing Qi, Yang Yang, and Deyan He, AlCl₃-induced Crystallization of Amorphous Silicon Thin Films, *Applied Surface Science*, 254, 2605-2608 (2008)
- 6、Jing Qi, Yinghu Yang, Effect of sputtering parameters on room-temperature ferromagnetism in Er-doped ZnO thin films, 2nd WUN international Conference on Spintronic Materials and Technology WUN-Spin08, Nanjing, China, July 13-16, 2008
- 5、祁菁, 贺德行, AlCl₃诱导晶化法制备多晶硅薄膜, 第十六届全国半导体物理学术会议论文, 中国兰州, 2007年9月, pp.105. Qi Jing, He Deyan, The poly-Si thin films prepared by AlCl₃-induced crystallization, presented at the 16th National Conference on Semiconductors, Lanzhou, Gansu, CHINA, September 7-13, 2007, pp.105.
- 4、胡海龙; 彭尚龙; 唐泽国; 祁菁; 贺德行, 在AAO衬底上制备纳米Si阵列研究, 兰州大学学报(自然科学版), 43 (2007) 96-98. HU Hai-long, PEN G Shang-long, TANG Ze-guo, QI Jing, HE De-yan, Preparation of nano-crystalline Si arrays by plasma enhanced CVD using porous alumina templates, *J. Lanzhou University (Natural Science)* 43 (2007) 96-98;
- 3、祁菁, 金晶, 胡海龙, 高平奇, 袁保和, 贺德行, H₂对Ar稀释SiH₄等离子体CVD制备多晶硅薄膜的影响, 物理学报, 55 (2006) 5959-5963. Qi Jing, Jin Jing, Hu Hai-long, Gao Ping-Qi, Yuan Bao-He, He De-Yan, Effect of H₂ on polycrystalline Si films deposited by plasma-enhanced CVD using Ar-diluted SiH₄, *Acta Phys. Sin.*, 55 (2006) 5959-5963
- 2、祁菁, 金晶, 胡海龙, 贺德行*, Al诱导a-Si:H薄膜的晶化, 真空科学与技术, 25 (2005) 57-60. Qi Jing, Jin Jing, Hu Hailong, He Deyan, Al-induced Crystallization of Hydrogenated Amorphous Silicon Films, *J. Vac. Sci. Tech. (China)* 25 (2005) 57-60.
- 1、王晓强, 栗军帅, 陈强, 祁菁, 尹旻, 贺德行*, 电感耦合等离子体CVD低温生长硅薄膜过程中的铝诱导晶化, 物理学报, 54 (2005) 269-273. Wang Xiao-Qiang, Li Jun-Shuai, Chen Qiang, Qi Jing, Yin Min, He De-Yan, Aluminium-induced crystallization during deposition of silicon films by inductively coupled plasma

发表论文：

研究成果:

研究组成员:

登陆修改